

大見研究室 和文 論文リスト

1999 年

- 866(P) 大見忠弘、「革命期を迎えた半導体技術」、第 30 回記念セミコンファレンス講演予稿集、(電気化学会東北支部)、pp.9-12、1999 年 1 月。
- 867(M) 大見忠弘、「一巻頭言一次世代半導体のための新素材」、ウルトラクリーンテクノロジー Vol.11、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.2-6、1999 年 2 月。
- 868(M) 伊野和英、大見忠弘、「不純物拡散を抑えたウルトラクリーンガス排気システム＝ターボ分子ポンプの排気速度向上と逆拡散抑止技術＝」、クリーンテクノロジー、(日本工業出版)、Vol.9、No.3、pp.48-53、1999 年 3 月。
- 869(P) 河合邦浩、牛木健雄、大嶋一郎、大見忠弘、「Ta/SiO₂ 界面反応層がタンタルゲートMOSデバイスの特性に与える影響」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.98、No.652、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM98-222、pp.83-89、1999 年 3 月。
- 870(P) 大見忠弘、「省エネルギー・省資源・環境対応型半導体・TFT製造技術」、第 10 回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(日本ポール株)、pp.1-10、1999 年 3 月。
- 871(P) 永瀬正明、北野真史、中村修、白井泰雪、大見忠弘、「高精度プロセスガス供給システム」、第 10 回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(日本ポール株)、1999 年 3 月。
- 872(P) 馬場崎晋一、白井泰雪、北野真史、永瀬正明、堀越基伸、国雲良二、大見忠弘、「ICP-MSを用いたメタル汚染防止技術の効果確認について」、第 10 回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(日本ポール株)、1999 年 3 月。
- 873(P) 丸尾和幸、高柳史一、大見忠弘、「 ν MOSアナログ技術を応用した直線Hough変換回路の試作」、1999 年電子情報通信学会総合大会講演論文集、基礎・境界、((社)電子情報通信学会)、pp.150、1999 年 3 月。
- 874(P) 大見忠弘、森田行則、「シリコンと酸化物をつなぐ道ーその極限制御ー」、第 46 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集 No.0、(応用物理学会)、pp.33、1999 年 3 月。
- 875(M) 寺西洋志、古堅宗勝、東茂樹、安藤善信、大見忠弘、「超高純度ガス供給用ステンレス鋼管の開発」、大河内賞受賞業績報告書 平成 10 年度〔第 45 回〕、((財)大河内記念会)、pp.27-33、1999 年 4 月。
- 876(M) 大見忠弘、「革命期を迎える半導体技術及びTFT-LCD技術」、東北大学学報、(東北大学)、pp.3-5、1999 年 5 月。
- 877(P) 大見忠弘、「低価格生産・高効率半導体製造技術」、第 33 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-16、1999 年 5 月。
- 878(P) 熊巳創、大見忠弘、「低エネルギーイオン照射を用いたシリコン薄膜形成技術」、第 33 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.27-30、1999 年 5 月。
- 879(P) 関根克行、海原竜、斉藤祐司、平山昌樹、大見忠弘、「マイクロ波励起高密度プラズマを用いた極薄ゲート絶縁膜形成技術」、第 33 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.31-39、1999 年 5 月。
- 880(P) 森井明雄、平山昌樹、大見忠弘、「マイクロ波励起高密度プラズマCVD装置の開発」、第 33 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.40-50、1999 年 5 月。

- 881(P) 中村修、永瀬正明、北野真史、白井泰雪、大見忠弘、「高精度プロセスガス供給システム」、第 33 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.51-68、1999 年 5 月。
- 882(P) 安藤清、阿久津功、大見忠弘、「不等リードスクルー型真空排気システムの開発」、第 33 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.76-77、1999 年 5 月。
- 883(P) 新田雄久、都賀智仁、原田康之、大見忠弘、「高性能枚葉洗浄装置」、第 33 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.153-161、1999 年 5 月。
- 884(P) 三森健一、芳賀宣明、笠間泰彦、今岡孝之、高橋典久、大見忠弘、「省資源・超高速大型ガラス基板洗浄」、第 33 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.162-167、1999 年 5 月。
- 885(P) 毛塚健彦、板野充司、大見忠弘、「高選択性・非選択性酸化膜エッチング」、第 33 回超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.168-174、1999 年 5 月。
- 886(M) 大見忠弘、「Ⅲ章 脳を創る 2 シリコンチップに脳機能を蓄積する 四端子デバイスが切り拓く連想知能エレクトロニクスの世界」、脳を知る・創る・守る③、(株クバプロ)、pp.94-113、1999 年 5 月。
- 887(M) 牛木健雄、伊野和英、大嶋一郎、河合邦浩、島田浩行、大見忠弘、「低抵抗bcc-TaゲートCMOS技術」、シリコンテクノロジー、No.10、(応用物理学会分科会)、pp.23-27、1999 年 6 月。
- 888(F) 大見忠弘、「半導体製造工場におけるガス使用量削減化技術」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.11、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.164-168、1999 年 6 月。
- 889(P) 大見忠弘、「省エネルギー・省資源・環境対応型半導体・TFT製造技術」、第 17 回 BOC EDWARDS 半導体セミナー、(大阪酸素工業(株)、日本エドワーズ(株))、pp.70-76、1999 年 6 月。
- 890-1(M) 大見忠弘、「極微半導体プロセスと次世代電子集積回路」、第 30 回精研シンポジウム「極微半導体プロセスと次世代光電子デバイス」予稿集、pp.45-55、1999 年 6 月。
- 891(P) 大見忠弘、関根克行、斉藤祐司、平山昌樹、「画期的なステップ数削減の液晶製造プロセス」、第 9 回ファインプロセステクノロジー・ジャパン'99、(リードエグジビションジャパン(株))、pp.11-15、1999 年 6 月。
- 892(M) 大見忠弘、「半導体製造装置 21 世紀の展望」、ブレイクスルー、No.157、(株リアライズ社)、pp.2-4、1999 年 7 月。
- 890-2(P) 大見忠弘、「革命期を迎える半導体生産方式」、分析科学技術交流夏季セミナー99、(日本分析化学会東北支部、東北分析科学技術交流会)、1999 年 7 月。
- 893(M) 斉藤祐司、関根克行、平山昌樹、大見忠弘、「マイクロ波励起高密度プラズマを用いた高品質シリコン窒化膜の低温形成」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.99、No.231、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 ED99-95,SDM99-69,ICD99-77、pp.85-90、1999 年 7 月。
電子情報通信学会技術研究報告、Vol.99、No.229、電子デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 ED99-95,SDM99-69,ICD99-77、pp.85-90、1999 年 7 月。
電子情報学会技術研究報告、Vol.99、No.233、集積回路、(電子情報通信学会)、論文番号 ED99-95,SDM99-69,ICD99-77、pp.85-90、1999 年 7 月。

- 894(M) 熊巳創、進藤亘、本藤哲史、大見忠弘、「低エネルギーイオン照射を用いたシリコン薄膜形成時に生じるドーパント(As,P,Sb,B)の不活性化」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.99、No.231、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 ED99-97,SDM99-71,ICD99-79、pp.97-104、1999年7月。
- 電子情報通信学会技術研究報告、Vol.99、No.229、電子デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 ED99-97,SDM99-71,ICD99-79、pp.97-104、1999年7月。
- 電子情報通信学会技術研究報告、Vol.99、No.233、集積回路、(電子情報通信学会)、論文番号 ED99-97,SDM99-71,ICD99-79、pp.97-104、1999年7月。
- 895-1(M) 大見忠弘、「特集 半導体製造プロセス用ケミカルの新展開(Part1) 総論」、ファインケミカル、Vol.28、No.14、(株シーエムシー)、pp.5-8、1999年8月。
- 896(M) 大見忠弘、伊井稔博、グン・ミン・チョイ、「低環境負荷シリコン基板洗浄技術」、ファインケミカル、Vol.28、No.15、(株シーエムシー)、pp.20-27、1999年9月。
- 897(M) 大見忠弘、「今、半導体王国復活に求められる技術はこれだ!」、大見忠弘教授が提唱する日本半導体の新たな挑戦—今、半導体王国の復活に求められる技術はこれだ!—、(半導体産業新聞)、1999年9月。
- 898(M) 平山昌樹、関根克行、斉藤祐司、大見忠弘、「低価格・高効率生産性の半導体生産システム—出揃った新プロセスの有効手段—」、大見忠弘教授が提唱する日本半導体の新たな挑戦—今、半導体王国の復活に求められる技術はこれだ!—、(半導体産業新聞)、1999年9月。
- 899(P) 大見忠弘、「ネットワーク時代のシステムLSI」、1999年VDEC LSIデザイナーフォーラム講演論文集、(東京大学大規模集積システム設計教育研究センター(VDEC))、pp.2-11、1999年9月。
- 900(P) 小谷光司、大見忠弘、「オフセットフリー・DC電流フリー電荷転送アナログ回路技術」、1999年VDEC LSIデザイナーフォーラム講演論文集、(東京大学大規模集積システム設計教育研究センター(VDEC))、pp.86-93、1999年9月。
- 901(P) 野澤俊之、藤林正典、今井誠、大見忠弘、「演算省略機能を有するベクトル量子化プロセッサの設計体験」、1999年VDEC LSIデザイナーフォーラム講演論文集、(東京大学大規模集積システム設計教育研究センター(VDEC))、pp.120-121、1999年9月。
- 902(M) 小島泉里、自在丸隆行、尾前俊吉、大見忠弘、「メガソニックを用いた室温レジスト剥離技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.99、No.339、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 SDM99-145、pp.39-45、1999年9月。
- 903(M) 今泉文伸、濱田龍文、金本啓、大見忠弘、「イオン注入により形成されるドーパントに絡んだ欠陥とそのドーパント種依存性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.99、No.340、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 SDM99-147、pp.1-5、1999年9月。
- 904(M) 本藤哲史、熊巳創、進藤亘、大見忠弘、「低エネルギーイオン照射を用いたボロンドープシリコン単結晶薄膜の形成」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.99、No.340、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、論文番号 SDM99-148、pp.7-11、1999年9月。
- 905(F) 大見忠弘、「半導体製造プロセスにおけるクリーン化技術」、表面技術、Vol.50、No.10、((社)表面技術協会)、pp.848-854、1999年10月。
- 906(F) 永瀬正明、白井泰雪、大見忠弘、「高精度プロセスガス供給システム=チャンバ内のガス組成と圧力の完全制御=」、クリーンテクノロジー、(日本工業出版)、Vol.9、No.11、pp.14-16、1999年11月。
- 907(F) 馬場崎晋一、堀越基伸、国雲良二、白井泰雪、北野真史、永瀬正明、大見忠弘、「ICP-MSを用いたメタル汚染防止技術の効果確認」、クリーンテクノロジー、(日本工業出版)、Vol.9、No.11、pp.17-21、1999年11月。
- 895-2(P) 大見忠弘、「超LSI高性能化の方向と低生産価格を可能にする製造技術」、早稲田大学材料技術研究所オープンセミナー(1999年)テキスト、(早稲田大学)、1999年11月。

- 908(P) Zhibin Pan, Koji Kotani, Tadahiro Ohmi, 「A system for generating speech index based on speaker identification technique through VQ」、第3回システムLSI琵琶湖ワークショップ、((社)電子情報通信学会集積回路研究専門委員会)、pp.253-238、1999年11月。
- 909(M) 大見忠弘、「革命期を迎える半導体産業」、熊谷組技術研究報告、(株熊谷組)、第58号、pp.1-2、1999年11月。
- 910(M) 大見忠弘、「変革の時を迎える半導体産業」、高砂熱学工業総合研究所報、(高砂熱学工業株)、No.13、pp.1、1999年11月。
- 911(W) 中村修、大川猛、大見忠弘、「水分発生器を用いた高信頼性を有する極薄ゲート酸化膜の形成」、第10回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.25-30、1999年11月。
- 912(W) 菅田正宏、大見忠弘、「時空間座標ベクトル量子化を用いた動画像圧縮システム」、第10回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.33-38、1999年11月。
- 913(W) 海原竜、米田博之、伊野和英、平山昌樹、大見忠弘、「バランスド電子ドリフト(BED)マグネトロンエッチャーによるダメージフリーコンタクトエッチング」、第10回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.51-58、1999年11月。
- 914(W) 小島泉里、自在丸隆行、尾前俊吉、阿部俊和、大見忠弘、「メガソニック照射を用いた室温レジスト剥離技術」、第10回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.61-66、1999年11月。
- 915(W) 大見忠弘、「革命期を迎える半導体技術」、第10回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.75-86、1999年11月。
- 916(P) 大見忠弘、「新しいプロセスを可能にするプロセス雰囲気清浄技術」、平成11年度日本真空協会仙台研究例会「機能性薄膜作成プロセスにおける清浄度の意味合い」予稿集、(日本真空協会)、pp.1-32、1999年12月。
- 917(P) 笠間泰彦、蔡基成、佐々木真、福田航一、大場知文、北川均、仲野陽、小野昭一、福原圭司、中村雅一、渡部嘉、山田一彦、菊池正志、石川道夫、大見忠弘、「TFT・LCD製造プロセスにおけるプロセス雰囲気清浄性」、平成11年度日本真空協会仙台研究例会「機能性薄膜作成プロセスにおける清浄度の意味合い」予稿集、(日本真空協会)、pp.43-49、1999年12月。
- 918(M) 大見忠弘、「ネットワーク対応インテリジェントシステムLSI用超低価格製造ライン創出を目指して」、ウルトラクリーンテクノロジー、(半導体基盤技術研究会)、Vol.11、No.6、pp.346-347、1999年12月。